

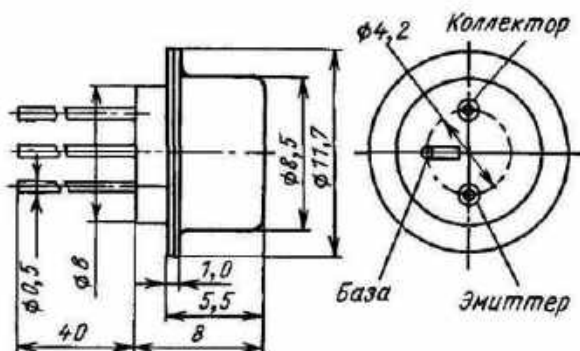
МП16, МП16А, МП16Б

Транзисторы германиевые сплавные *p-n-p* переключаемые низкочастотные маломощные

Предназначены для применения в схемах переключения и формирования импульсов

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 2 г



Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$, $I_Э = 1 \text{ мА}$ не менее

МП16, МП16А	1 МГц
МП16Б	2 МГц

Время переключения при $U_{КЭ} = 15 \text{ В}$, $R_К = 1,5 \text{ кОм}$ не более

МП16	2 мкс
МП16А	1,5 мкс
МП16Б	1 мкс

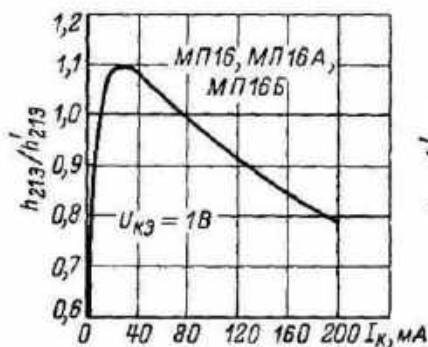
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 1 \text{ В}$, $I_К = 10 \text{ мА}$.

при $T = 293 \text{ К}$	
МП16	20–35
МП16А	30–50
МП16Б	45–100
при $T = 213 \text{ К}$	
МП16	10–35

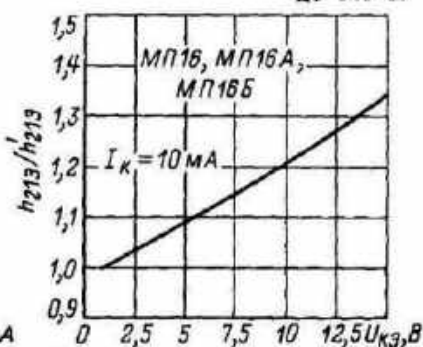
МП16А	15—50
МП16Б	23—100
при $T = 343 \text{ К}$.	
МП16	20—80
МП16А	30—100
МП16Б	45—200
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10 \text{ мА}$, $I_B = 1 \text{ мА}$ не более	
	0,15 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 10 \text{ мА}$, $I_B = 1 \text{ мА}$ не более	
	0,35 В
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = 15 \text{ В}$, $U_{БЭ} =$ $= 0,5 \text{ В}$ не более	
при $T = 293 \text{ К}$	25 мкА
при $T = 343 \text{ К}$	200 мкА
Импульсный обратный ток коллектор-эмиттер при 293 К, $U_{КЭ} = 12 \text{ В}$, $R_K = 1,5 \text{ кОм}$ не более	
	400 мкА

Предельные эксплуатационные данные

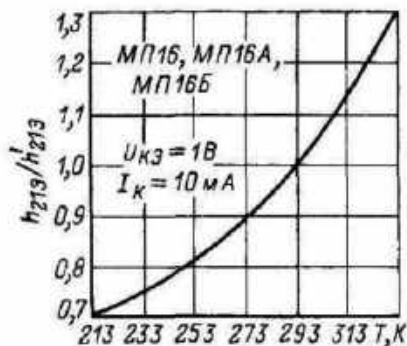
Постоянное напряжение коллектор-база	15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} <$ $< 2 \text{ кОм}$	15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	15 В
Импульсный ток коллектора	300 мА
Импульсный ток эмиттера	300 мА
Среднее значение тока эмиттера	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:	
при $T = 213 - 318 \text{ К}$, $p \geq 6666 \text{ Па}$	200 мВт
при $T = 213 - 318 \text{ К}$, $p = 665 \text{ Па}$	100 мВт
при $T = 343 \text{ К}$	75 мВт
Общее тепловое сопротивление *.	200 К/Вт
Температура перехода	358 К
Температура окружающей среды	От 213 до 343 К



Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером от тока коллектора.



Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером от напряжения коллектор-эмиттер.



Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером от температуры.

Зависимость относительного времени рассасывания от температуры.

Зависимость относительного напряжения насыщения база-эмиттер от температуры.

